TÍTULO : FORMAÇÃO DE FASES EM SISTEMAS SÓLIDOS

115.5

.

AUTOR : RUTE HELENA TREVISAN BRUNC ORIENTADOR : WOLFGANG MAY



A Ruth, Cezar e Margareth.

.

.

.

A minha filha Andressa.

AGRADECIMENTOS

Ao Dr. Wolfgang May, meu orientador, pelo estímulo e perseverança.

Ao Prof.Dr. S. Caticha Ellis, pelo apoio e incentivo, em todos os momentos deste trabalho.

Ao Dr. E. Farah, pelas discussões e amizade.

À Dra. Iris Torriani, pelo apoio dado.

Ao Dr. Carlos A. Ribeiro, pelas análises feitas em P<u>a</u>ris.

Ao colega Arlindo Antonio Savi, pela ajuda nos polime<u>n</u> tos das amostras.

Ao colega Cicero Campos, pelo incentivo e amizade.

Ao Sr. Clenio P. Casarin, pelo auxílio nos trabalhos de oficina e vácuo.

Ao Sr. José Alfredo Fraymann, pelos trabalhos de fot<u>o</u> grafia.

A todos que, direta ou indiretamente ajudaram neste tr<u>a</u> balho.

RESUMO

Na primeira parte do trabalho, desenvolvemos as condições termodinâmicas para o estudo dos dois mais importantes mecanismos de transporte em sólidos : reações controladas por difusão e controladas na interface.

A dependência do tempo do crescimento das fases dos produtos de reação foi determinada como um critério decisivo p<u>a</u> ra a caracterização do tipo de reação.

Como exemplos experimentais, foram estudadas as rea ções nos sistemas Fe-Ti e no sistema SiO₂-Al. A formação de fases intermetálicas FeTi e Fe₂Ti foi analisada como um processo controlado por difusão, enquanto que a formação da fase Al₂O₃ mostrou ser um processo controlado por reação na interface.

ÍNDICE

Parte 1 - Introdução

Parte 2 - Teoria de Reações em Sólidos

2.1 - Introdução à Teoria das Reações em Sólidos

2.2 - Diagrama de Equilíbrio das Fases

2.3 - Reações químicas

2.4 - Cinética da reação por difusão

2.5 - Formação de Fases por Difusão

2.6 - Reação Controlada na Interface

Parte 3 - Técnicas Experimentais

' 3.1 - Preparação das amostras

3.1.1 - Obtenção do par Fe-Ti

3.1.2 - Obtenção do SiO₂-Al (evaporado)

3.1.3 - Obtenção do par SiO₂-Al (metálico)

3.2 - Equipamentos Utilizados nas Análises

Parte 4 - Resultado das análises e discussão

4.1 -Introdução

4.2 -Análise ao Microscópio Ótico

4.3 -Análise qualitativa e quantitativa na Microssonda Elet.

4.4 "Discussão dos resultados obtidos.

Referências Bibliográficas . Tabelas

Figuras e Fotos

INTRODUÇÃO

O estudo das reações em solidos ganhou nas duas últimas décadas uma crescente importância na física do estado solido por dois motivos principais: um dêles, o aperfeiçoamento das condi ções analíticas com o aprimoramento dos instrumentos de análise física, e o outro seria a necessidade cada vez maior de sua aplicação na indústria, como por exemplo na fabricação de supercondutores, semi-condutores, fibras óticas.

Através da termodinâmica e da cinética de reação, carac terizan-se dois tipos mais importantes de reações em sólidos : a) os processos controlados por difusão e b) por reação na interface. Este trabalho de pesquisa compreende o estudo destes dois aspectos das reações em sólidos e sua comprovação experimental. Este estudo foi feito através da formação de fases que aparecem nos sistemas : Fe-Ti e SiO₂-Al. O sistema Fe-Ti e caracterizado pela pequ<u>e</u> na diferença entre os pontos de fusão de seus componentes e coefi cientes de difusão aproximadamente iguais em ambos os lados do sistema. Por isto, o processo de penetração dos átomos de uma região na outra(região de fixação, interface original = região de formação de fases intermetálicas) é controlado: pela difu são . O sistema SiO₂-Al com pontos de fusão de seus elementos muito diferentes terã a interpenetração de seus elementos desiquilibrada, havendo certa dificuldade de penetração dos ato mos na interface. Nestas condições, é provável que um processo de crescimento de fases seja controlado pela Reação na Interface. A escolha destes dois sistemas em especial, se baseia no fato de que a formação de fases a eles inerente, facilita o es tudo das reações nos sólidos através de medidas de largura das fases formadas durante tratamento térmico.

Características do Fe-Ti

Em nossso trabalho, o motivo principal da escolha do sistema Fe-Ti foi sua característica de formar fases intermetálicas, facilitando desta maneira o estudo das reações. Além disso, o estudo do sistema Fe-Ti é interessante devido sua característica de formar hidretos de metal. Estes hidretos são perfeitos armazenadores de hidrogênio, possibilitando assim o transpo<u>r</u> te do mesmo, de forma conveniente.

Para armazenar H, o Fe-Ti passa por um ciclo de absorção, onde o material Fe-Ti é mantido em estado ativado, a 350 $^{\circ}$ C e a baixa pressão(10⁻² mbar). Um recipiente, de massa total 6,3K contendo uma liga pura de Fe-Ti pode guardar 77g de hidrogênio, enqu enquanto que um tubo que contém gas de hidrogênio a alta pressão pesando 17 K, contém somente 150 g de hidrogênio.

Fizemos experimentos com pequenos blocos de Fe-Ti p<u>u</u> ros, usando para tratamento térmico a temperatura de 1000 ^O C, já que a temperatura de fusão dos dois elementos é alta (Fe -1536 ^OC e Ti - 1668 ^OC).As análises qualitativas e quantitat<u>i</u> vas foram feitas após tratamento térmico, na Microssonda Eletrônica e por difratometria de raios-X.

Características do SiO2-A1

O estudo da formação de fases no sistema SiO_2 -Al é in teressante sob dois aspéctos : um de ordem acadêmica no estudo dos transportes em sólidos e outro de ordem prática, na fabrica ção de fibras óticas. A fabricação de fibras óticas pelo método de deposição química pela evaporação(4) utiliza a técnica de oxidação ou hidrólise de compostos voláteis. Um fluxo de gás é introduzido num tubo de quartzo, que é aquecido a altas tempera turas (~ 1300 °C) havendo assim uma deposição homogênea do pro duto de reação sobre as paredes do tubo. Porém em alguns casos tem surgido como produto de reação partículas metálicas, que também se depositam sobre a superfície do tubo e são impurezas que modificam o gradiente de concentração do filme fino, e consequentemente acarretam perdas de energia. 4

No estudo da física dos sólidos, as reações do tipo m<u>e</u> tal óxido merecem especial atenção no sentido de que elas formam fases intermediárias (ver diagrama de equilíbrio das fases na f<u>i</u> gura 2-a) que possibilitam o estudo do mecanismo das reações.

O sistema SiO₂-Al foi escolhido tendo em vista exata mente esta formação de fases que ocorre devido a grande diferença dos valôres de energia livre: de formação dos elementos componentes . Normalmente à 600 °C o SiO₂ é muito estável.Porém, como o calor de formação do SiO₂ (- 690 . 10^{-6} J/Kg mol) é bem menos negativo que do Al₂O₃ (-1406 . 10^{-6} J/Kg mol) que é o óxido fo<u>r</u> mado durante a reação, tem-se a possibilidade da ocorrência de reações à temperaturas relativamente baixas.

Usamos a temperatura de ~ 630 °C para os tratamentos térmicos pois notamos que a maioria dos trabalhos feitos na lit<u>e</u> ratura atual , são realizados à temperaturas maiores que 1000°C.

Na parte experimental foram feitas variações disti<u>n</u> tas, usando-se blocos de quartzo natural sendo que numa prime<u>i</u> ra etapa trabalhou-se com alumínio evaporado sobre quartzo, e numa segunda etapa, blocos de alumínio sobre quartzo em amos tras do tipo sanduiche. 5

A fim de determinar as fases presentes na reação, f<u>o</u> ram feitas análises qualitativas e quantitativas com Microsso<u>n</u> da Eletrônica e por difratometria de raios-X.Para as medidas de largura das fases usou-se um microscópio ótico.

G

PARTE 2

TEORIA DAS REAÇÕES NOS SÓLIDOS

2.1 - INTRODUÇÃO

No estudo das reações químicas, a propriedade extensiva de um sistema da mais relevante importância, é a energia livre de Gibbs <u>G</u>. G é uma função de estado (5) que depende da pressão, temperatura e do número de moles das espécies pre sentes no sistema. A função G é definida como :

 $G(p,T,n_1,...n_i) = H - TS$ (1)

onde H entalpia do sistema

T temperatura absoluta de reação

S entropia do sistema

n, número de moles das espécies presentes

Porém, ao ocorrer uma reação química, A + B → AB , haverá uma variação de energia livre ΔG; então a equação acima, para pressão e temperatura: constantes, é escrita como :

 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

Os valõres numéricos de \triangle G para uma reação química entre duas fases homogêneas A e B estão tabelados (bibliogr<u>a</u> fia de termodinâmica química) e são facilmente calculados atr<u>a</u> vés da equação (2) abaixo (cálculos no item 2.2). 6

$$\Delta G_{T} = \Delta H_{298} + \int_{298}^{T} \Delta C_{p} dT - T\Delta S_{298} - T \int_{298}^{T} \Delta C_{p}/T dT (2)$$

7

onde △G_T - variação de energia livre do processo à temperatura T.

 Δ H₂₉₈ - variação de entalpia do sistema à T=298 ^oK

 \triangle C_p - variação de calor específico à pressão cte

 Δ S₂₉₈ - variação de entropia à 298[°]K

Estas considerações termodinâmicas de uma reação qu<u>í</u> mica, independem dos mecanismos de transporte envolvidos.

A seguir, estudar-se-a os vários processos de ocor-#rência de reações em sólidos, considerando-se o transporte e introduzindo-se o tempo de reação.

O processo mais simples de ocorrência de reações em sólidos se dá quando uma mistura mecânica (pulverizada) de dois elementos A e B , completamente solúveis um no outro é submet<u>i</u> da a determinada temperatura T.

A energia livre da mistura mecânica de A e B é dada pelo valor de G(N) ,G^O(N) no ponto <u>1</u> do diagrama da figura 1. Pode-se dizer que o valor de G^O(N) é dado por :

 $G^{O}(N) = G^{O}_{A} N_{A} + G^{O}_{B} N_{B}$ (3)

onde G^{O}_{A} e G^{O}_{B} são as energias livres de A e B puros.

Neste caso, a distância média entre dois átomos A e B é tão pequena que pode ser desprezada, e isto torna o transpor te atômico praticamente nulo, fazendo com que a reação se processe quase que instantanezmente, mesmo que seja necessário o uso de um catalisador. A curva de energia livre G(N) desta solução com n_A moles de A e n_B moles de B, à temperatura constante T em função da composição N (N = $N_A = n_A / n_A + n_B = 1 - N_B$) deve ser dada pela curva da figura 1 (5). 8

Durante a formação da solução A-B, o valor da emergia livre vai diretamente para o ponto 2 do diagrama da figura 1, ponto este que é o de mínima energia livre para esta concentração de A e B.

Termodinamicamente, o processo é descrito como segue.

Pela figura 1, o valor de G(N), energia livre da s<u>o</u> lução é dado por :

$$G(N) = (G_A^O + \Delta G_A) N_A + (G_B^O + \Delta G_B) N_B$$
(4)

onde $\Delta G_A = \Delta \overline{G}_B = variação de energia livre molar parcial$ $<math>(G_A^O + \Delta \overline{G}_A) = \mu_A$ $(G_B^O + \Delta \overline{G}_B) = \mu_B$ potencial químico de A e B

A variação de energia livre devido a formação da s<u>o</u> lução será a diferença entre a energia livre da solução G(N) e a energia livre de A e B puros. Isto é dado por :

$$\Delta G(N) = G(N) - G^{O}(N)$$
(5)

onde $G^{O}(N)$ e G(N) são dados respectivamente pelas equações 3 e 4.

Logo , a equação(5) fica :

$$\Delta G(N) = (G_A^{o} + \Delta G_A)N_A + (G_B^{o} + \Delta G_B)N_B - (G_A^{o} N_A + G_B^{o}N_B)$$
$$\Delta G(N) = \Delta \overline{S}_A N_A + \Delta \overline{G}_B N_B$$
(6)

A condição de se ter um ou mais compostos dos átomos A e B após a reação química, é governada pelo diagrama de equilíbrio das fases do sistema (parte 2.2). 9

No caso de se ter A e B compactos, a reação entre estes elementos, a determinada temperatura T, não se processa instantaneamente. Para a totalidade da amostra atingir o estado de equilibrio descrito pelo diagrama da figura 2-a, seria n<u>e</u> cessário um tempo infinito. Para um tempo determinado de trat<u>a</u> mento térmico, ocorre a formação de um gradiente de concentração, o que é uma situação de não equilíbrio para a amostra total.

Sendo assim, para a descrição da cinética do proc<u>e</u> sso, se faz necessária a introdução do tempo gasto na reação.

Com esta admissão do tempo, não se pode aplicar a termodinâmica clássica no estudo da amostra total. Porém, Darken(21), encontrou uma solução para este tipo de reação, intro duzindo o <u>Modelo de Equilíbrio Local</u>. Neste modelo, ele considerou cada pequeno elemento de volume Δv , em equilíbrio com ele mesmo. Deste modo, pode-se aplicar a termodinâmica clássica a cada elemento de volume , obtendo-se assim, uma descrição da amostra total.

Para um sistema A-B completamente solúvel, ocorre , para um determinado tempo de tratamento térmico a uma temperat<u>u</u> ra T, uma variação contínua da concentração com a posição na amostra. Quando os sistemas não são completamente solúveis, isto • é, quando existe formação de fases a **()** dada temperatura T, a situação nas interfaces de concentração $N_{\alpha\beta}$, $N_{\beta\alpha}$, $N_{\beta\gamma}$ e $N_{\gamma\beta}$, p<u>a</u> ra este modelo de equilíbrio local, está no esquema da figura 2 a. Pode-se dizer que cada elemento da amostra, está em concordâ<u>n</u> cia com este diagrama de equilíbrio das fases do sistema.

Se o transporte da reação é controlado apenas pela d<u>i</u> fusão , o diagrama de energia livre(Fig. 2-b) e a curva do pote<u>n</u> cial químico(Fig. 2-c) determinam os valores da "driving force" Δ G_A.

A curva de variação da concentração <u>N</u> com a distância <u>x</u> na amostra, para este processo controlado pela difusão, está na figura 2-d.

Enfocando a situação apenas na região das interfaces, (Fig. 3) a constância do potencial químico (Fig. 3-a), mostra que não existe uma influência das interfaces no transporte das partículas. Um outro fator de influência direta no processo, é a energia de ativação do transporte G_A^* que está diretamente relacionada com a interação das partículas.

Na Fig. 3-b observa-se a constância da energia de at<u>i</u> vação para uma partícula atravessando uma interface. Essa constância é típica para processos que não sofrem influência da interface e são controlados apenas pela difusão.

No caso de se ter um grande aumento na energia de ativação na região da interface, mostrando com isso a grande dificuldade dos átomos para ultrapassarem a região, caracteriza-se esta reação como <u>Controlada na Interface</u>. A figura 4 mostra a situação na região da interface, que neste caso, foge da situação de equilíbrio local do modelo anterior. 10

A energia de ativação proxima à interface(Fig. 4-b) possui valor muito maior que aquela das regiões distintas da mesma, onde ocorre somente a difusão, que é o processo mais rápido neste caso.Este fato leva a uma descontinuidade na cu<u>r</u> va do potencial químico da amostra, nas regiões vizinhas à i<u>n</u> terface (Fig. 4-a).Esta brusca queda no potencial químico provoca também uma distorção nos valores de concentração, havendo uma consequente "abertura" nos "gaps" de micibilidade(Fig. 5-c). Neste caso a curva do potencial químico em função da con centração(Fig. 5-b) é uma curva que apresenta descontinuidade nas regiões imediatamente próximas da interface.

Para a descrição deste dois modelos de reação, se torna indispensável a discussão de processos atomísticos e suas relações comºa termodinâmica.

Considerando-se o processo da difusão dentro de um gradiente de concentração, a velocidade \underline{v} das partículas é dada (17) pelo produto da força F que age sobre elas, pela mobilidade <u>M</u> das mesmas. Seja uma partícula do tipo <u>i</u>. Sua velocidade é dada por :

$$v_i = d_{s_i} / dt = M_i \cdot F_i$$
 (7)

Para variações infinitesimais de elementos de volume △ V dos materiais em reação pode-se escrever(8) :

 $\Delta \mathbf{G}_{\mathbf{m}} / \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{G}_{\mathbf{m}}^{\mathbf{D}} / \Delta \mathbf{V}$

onde ΔG_m variação de energia livre molar

 ΔG_m^D variação de energia livre molar devido aos processos de difusão.

A redução de energia livre do sistema durante a reação, está diretamente relacionada com a energia livre dissipada em processos difusionais : 11

$$\Delta G_{m} / V = \Delta G_{m}^{D} / V \qquad (8)$$

Nos itens 2.4 e 2.5 dá-se as leis da cinética contro_ lada pela difusão para um sistema onde ocorre formação de fa ses.Quando os passos da reação na interface são muito lentos em relação a processos de difusão, pode-se então ter uma"que bra" do equilíbrio na região vizinha a interface.Neste caso há a possibilidade de que a reação total seja controlada pela reação na interface. Então tem-se que :

$$\Delta G_{m} / V = \Delta G_{m}^{I} / V \qquad (9)$$

onde

le
$$\Delta G_m^I$$
 = variação de energia livre molar devido a reação
na interface

Consequentemente pode ocorrer uma mudança nas leis
 do tempo da reação (Discussão no item 2.6).

Para um processo mais geral, pode-se escrever :

$$\Delta G_{m} / V = \Delta G_{m}^{D} / V + \Delta G_{m}^{I} / V \quad (10)$$

Dependendo da facilidade da reação na interface, ou por difusão, um dos termos da equação (10) acima pode dominar o outro.

Estes dois processos distintos de reação(reação por difusão e controlada na interface) são caracterizados pelas leis do tempo a eles relacionadas. Estas leis podem ser experi mentalmente determinadas em sistemas sólidos onde ocorre forma ção de fases, através de medidas de largura das fases em função do tempo de tratamento térmico.

É fundamental neste estudo das reações, o uso de dia

gramas de equilíbrio das fases, através dos quais pode-se ver quais as fases formadas a dada temperatura e quais os valores parciais de energia livre de reação. Estes diagramas <u>go</u> vernam a formação de fases na reação, dependendo da concentr<u>a</u> ção dos elementos, conforme ver-se-ã nos próximos itens.

•

2.2 DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO DAS FASES

Os valores parciais da variação de energia livre de um sistema, podem ser extraidos dos Diagramas de Equilíbrio das fases.

$$A + A_m B_n \rightarrow A_{m+1} B_n \qquad \Delta G(\Delta H, \Delta S)$$
 valores parciais

onde ΔG , ΔH e ΔS são expressos geralmente em termos de um $\underline{\tilde{a}}$ tomo do constituinte A(9).

O diagrama de equilíbrio das fases de um sistema, indica as fases presentes para uma dada temperatura, suas composições, e em que direção tendem a ocorrer se o sistema ainda não atingiu o equilíbrio (10).

Os diagramas de equilíbrio que apresentam menor margem de êrros são aqueles que são construidos a partir das curvas de energia livre do sistema para vários valores de te<u>m</u> peratura (19).

Numa reação com dois componentes A e B completamente solúveis, a curva da variação de energia livre em função da composição para a solução da reação , é dada pela figura 2.b.

A energia livre da solução binária consistindo de um componente A (de fração molar N_A) e de um componente B (de fração molar N_B) é dada pela equação 6 do item 2.1:

 $\Delta G(N) = \Delta \bar{G}_A N_A + \Delta \bar{G}_B N_B$

Se os componentes A e B não são completamente sol $\underline{\tilde{u}}$ veis um no outro, por problemas relativos a estrutura crist<u>a</u> lina, raio atômico, eletronegatividade ou valência, ocorre um "gap" de solubilidade sólida (11) que pode ser observado na figura 2.a,.Neste caso aparecem fases sólidas distintas, as quais variam de sistema para sistema e dependem também da te<u>m</u> peratura a que foi submetido o mesmo.

A figura 2 mostra a relação entre o diagrama de ene<u>r</u> gia livre e o de equilíbrio das fases para um sistema binário trifásico a dada temperatura T.

O diagrama de equilíbrio das fases para o sistema F<u>e</u> Ti está na figura 6. A temperatura de 1000 ^OC, na qual foram feitos os trabalhos experimentais, tem-se a formação das fases α Fe,TiFe₂, TiFe,Y Fe e β Ti, cujos tipos de rede estão na tab<u>e</u> 1a 1.

Para o estudo da reação SiO_2 -Al através de diagrama de fases, se faz necessário o estudo de dois diagramas disti<u>n</u> tos : o de Al-Si e o de SiO_2 -Al₂O₃. Isto porque não há na lit<u>e</u> ratura o diagrama de equilíbrio das fases Al-Si-O. Pode-se assim proceder, baseado no fato de ser grande a probabilidade de que ocorra uma redução do SiO₂ para Si por parte do Al, com

Na figura 7, tem-se o diagrama de equilíbrio para o sistema SiO₂-Al₂O₃ para temperaturas acima de 1400 ^OC e na figura 8 para o sistema Al-Si.

a consequente formação do óxido de alumínio(16).

Neste trabalho usou-se baixa temperatura de tratamen to térmico (630 °C) devido ao baixo ponto de fusão do A1(660 °C).

15

Assim como os diagramas de equilíbrio das fases for necem valores parciais de energia livre da reação, a termodin<u>â</u> mica fornece valores integrais de energia livre através de cá<u>l</u> culos numéricos.

.

2.3 A REAÇÃO QUÌMICA

Através da termodinâmica pode-se obter valôres num<u>é</u> ricos de energia livre, valôres estes que prevem a expontane<u>i</u> dade da reação. De acôrdo com o sinal destes valôres, para variações finitas (12) do sistema, tem-se que :

- 1°) △G ≤ 0 o processo ocorre expontaneamente
 a) △ G = 0 o processo é reversível
 b) △ G < 0 o processo é irreversível
- 2°) ∆ G > 0 o processo não ocorre expontaneamente porêm, seu inverso será expontâneo.

Estas variações de energia livre envolvidas na form<u>a</u> ção de uma liga binária a partir de seus constituintes são valores integrais de energia.

Se, por exemplo, os elementos A e B formam a liga AB, então :

хА + УВ - А_хВ_у мол му, жи (11)

onde ΔG , ΔH e ΔS da reação possuem valores integrais.

Os calculos numéricos dos valores integrais da variação de energia livre podem ser obtidos por vários métodos. Foi feito o calculo da variação de energia livre para a reação en tre quartzo e alumínio. Os resultados estão a seguir :

Cálculo Numérico de Valores Integrais de Energia Livre

Um dos caminhos para cálculo de energia livre de um processo é o cálculo de AG a partir de medidas de calor de formação, entropia e calor específico (9). A equação 6, item 2.1, da a variação de energia livre de um processo, em função
 das composições. Derivando a equação (6) em função da Temperatura:

$$\frac{d \Delta G}{d T} = \frac{\Delta \bar{G}_A}{\delta T} + \frac{N_A \delta \Delta \bar{G}_A}{\delta T} + \frac{\Delta \bar{G}_B \delta N_B}{\delta T} + \frac{N_B \delta \Delta \bar{G}_B}{\delta T}$$

onde N_A e N_B são composições de A e B. Para composições (N_A e N_B) constantes :

$$\frac{d \Delta G}{dT} = \frac{N_A d \Delta \bar{G}_A}{dT} + \frac{N_B d \Delta \bar{G}_B}{dT}$$
(12)
mas, $\Delta \bar{G}_A = RT \ln N_A$ e $\Delta \bar{G}_B = RT \ln N_B$ (13)

então ,

$$\frac{d \Delta G}{d\tau} = \frac{N_A d (RT \ln N_A)}{d\tau} + \frac{N_B d (RT \ln N_B)}{d\tau}$$

$$\frac{d \Delta G}{dT} = \mathbf{N}_{A} \left[\frac{T d(R \ln N_{A})}{dT} + \frac{R \ln N_{A}}{dT} \right] + \mathbf{N}_{B} \left[\frac{T d(R \ln N_{B})}{dT} + \frac{R \ln N_{B}}{dT} \right]$$

multiplicando ambos os lados da equação por T , e combinando as equações de Van'T Hoff*com o resultado, obtem-se :

 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S \tag{14}$

* Equações de Van'T Hoff :

$$\Delta H = T^{2} \frac{d R \ln N}{dT} \qquad \Delta S = - \frac{d \Delta G}{dT}$$

A equação (14) é válida para Δ G, Δ H e Δ S a temp<u>e</u> ratura dada T. Os valores de Δ H e Δ S são geralmente conhecidos e tabulados para a temperatura ambiente, portanto, os valores de Δ G podem ser calculados diretamente para esta : temperatura.

Para valores altos de temperatura, deve-se levar em conta as capacidades de calor ΔC_p , logo deve-se considerar a variação de entalpia,

$$H_2 - H_1 = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p dT$$
 (15)

e a variação de entropia (ΔS_T) de formação do composto a temperatura T :

$$\Delta S_{T} = \int_{0}^{T} \{\Delta C_{p} / T \} dT \qquad (16)$$

A partir das equações 14, 15 e 16 pode-se escrever:

$$\Delta G_{T} = \Delta H_{298} + \sum_{298}^{T} \Delta C_{p} dT - T \Delta S_{298} - T \int_{298}^{T} \Delta C_{p} / T dT (17)$$

O cálculo de AG para a reação abaixo, pode ser feito usando-se a equação (17).

$$a SiO_2 + b A1 \longrightarrow c Al_2 O_3 + d Si$$

Decompondo a reação, fica :

a) $\operatorname{SiO}_2 \operatorname{S} \longrightarrow \operatorname{Si}_S + (\operatorname{O}_2)_G(\Delta \operatorname{G}_I)$ b) $2((\Lambda 1))_L + 1 1/2 (\operatorname{O}_2)_G \longrightarrow \operatorname{Al}_2 \operatorname{O}_3 \operatorname{S}(\Delta^G \operatorname{I} I)$

19

A variação de energia livre do sistema é dada por : (Cálculo para T = 903 O K)

$$\Delta^{G}_{total} = G_{produto} - G_{reagente}$$
(18)

$$\underline{Calculo \ de \ A \ G_{I}}$$

$$\underline{SiO}_{2} \longrightarrow Si + (O_{2})$$

$$\Delta \ G_{I} = 210600 + 3.T.log \ T - 52,22.T$$

$$\Delta \ G_{I} = 210600 + 3(903) \log(903) - 52,22(903)$$

$$\Delta \ G_{I} = ^{\circ} + 170 \ \text{kcal/mol}$$

$$\underline{Calculo \ de \ A \ G_{II}}$$

$$2 \ ((Al))_{L} + 1 \ 1/2 \ (O_{2})_{G} \longrightarrow Al_{2}O_{3} \ S$$

$$\Delta G_{II} = -400810 + 3,98(903) \ \log(903) - 87,64(903)$$

$$\Delta G_{II} = - 332 \ \text{kcal/mol}$$

Pela equação 18, a variação total de energia livre

$$\Delta G_{\rm T} = -332 - (-170)$$

 $\Delta G_{\rm T} = -162$ kcal / mol

é:

isto é, $\Delta G \lt 0$, portanto esta reação se processa a 630 $^{\circ}C$ e é irreversível.

O cálculo numérico da variação de energia livre p<u>a</u> ra a reação

Fe + Ti -> FeTi

também pode ser calculada através da equação (17).

A variação de entalpia ∆H para a formação de FeTi vale ΔH = - 9,7 kcal/mol.

Os valores de energia livre de uma reação obtidos da equação 17 diferem dos valores de ΔG oriundos do diagrama de equilíbrio das fases estudado no item anterior(2.2), no sentido de que estes últimos são valores parciais, ao passo que a <u>e</u> quação 17 fornece valores integrais de energia.

Os valores integrais de energia livre, segundo um trabalho de Carnot,Van't Hoff, Gibbs e Helmholtz(9), podem ser relacionados com o conceito de "driving force", do ponto de vista que a energia livre de uma substância, sob determin<u>a</u> das considerações, é a porção máxima de energia que pode ser transformada em trabalho mecânico.

2.4 CINÉTICA DA REAÇÃO CONTROLADA POR DIFUSÃO

No estudo dos processos químicos que ocorrem nos s<u>ó</u> lidos, é imprescindível que se faça, além de considerações te<u>r</u> modinâmicas, outras referentes ao equilíbrio do sistema.Diz-se que um sistema, a pressão e temperatura constantes está em eequilíbrio , quando sua energia livre de Gibbs é um mínimo(13). Este mínimo da energia é alcançado quando o sistema passa de uma configuração de equilíbrio metaestável (de baixa energia livre porém , não mínima) para outra, de menor energia. Tais processos são esclarecidos por modelos atomísticos tais como os que se segue.

Um átomo, ao sofrer tal transformação(de um estado metaestável para outro) passa por dois mínimos de energia li vre, os quais são separados por um máximo (G_A^* na figura 9), o qual caracteriza o estado de transição. G_I é a energia livre do átomo no estado inicial e G_F no estado final. A "driving force " da reação é definida como :

$$\Delta G = G_F - G_T \tag{19}$$

Para que um atomo passe de uma configuração inicial para uma configuração final, ele deve ter energia livre sufic<u>i</u> ente para atingir o estado de transição.Esta energia é definida por :

$$G_{A} = (G_{A}^{*} - G_{I})$$
 (20)

a qual é a energia livre de ativação da reação.

22

A energia livre adicional necessária para um átomo superar esta barreira termodinâmica é obtida através de flutuaç<u>õ</u> es térmicas.

Pode-se dizer então que as velocidades das reações es tão relacionadas com a energia livre de ativação G_A^* e com a distribuição de energia resultante das flutuações térmicas, e que elas independem da "driving force". Esta última idéia está na figura 9 onde se ve que a energia livre de ativação G_A^* não está relacionada com a "driving force" Δ G : pode-se traçar inúmeras curvas começando em G_I e terminando em G_F . Diz-se que a " driving force" é independente dos processos de transporte envo<u>1</u> vidos(13).

A partir destas ideias, constata-se que a cinética da reação pode ser alterada sem que se altere a termodinâmica do processo.

O estudo das reações controladas por processos difusi<u>o</u> nais se torna simplificado quando se introduz o <u>modelo de equilí</u> <u>brio local</u>, anteriormente citado. Neste modelo, considera-se que para infinitesimais variações de volume <u>ΔV</u> existe um equilíbrio local no material em reação.

Hillert(8) caracteriza este modelo, definindo uma "dr<u>i</u> ving force" que é dada pela variação de energia livre por volume($\Delta G_m/V_m$). Usando esta definição pode-se dizer que, num processo controlado por difusão, nenhuma parte da "driving force" é dissipada durante os passos da reação na interface. Neste caso, escreve-se :

$$\frac{\Delta G_{m}}{V_{m}} = \frac{\Delta G_{m}^{D}}{V_{m}}$$

(21)

Pode-se estudar a cinética dos processos controlados por difusão através das relações de fluxo. Deste modo pode-se relacionar os coeficientes de difusão com grandezas mensuráveis conforme ver-se-a na descrição a seguir.

O modelo da reação controlada por difusão tem sido longamente estudado, pois ele pode predizer a razão de reação sem qualquer conhecimento prévio da reação em sí.

As reações químicas ocorrem devido ao movimento dos **ātomos.** A velocidade de um ātomo qualquer <u>i</u>, durante uma rea **ção**, é dada pela equação 7 (v_i = M_i F_i).

Por outro lado, as forças exercidas sobre um átomo A e um átomo B são dadas (7) por F_A e F_B :

$$F_{A} = -\frac{1/N_{avg}}{\delta x}, \quad \begin{pmatrix} \delta & \bar{G}_{A} \\ \delta & x \end{pmatrix}$$

(22)

$$F_{B} = - \frac{1}{N_{avg}} \delta \left(\Delta \overline{G}_{B} \right)$$

onde N_{avg}. - número de Avogrado (6,023 x 10^{23} átomos)

 $\Delta \tilde{G}_A \in \Delta \tilde{G}_B$ variação de energia livre molar parcial de A e B.

As variações de energia livre de A e B dadas pelas equações 13,

$$\Delta \overline{G}_{A} = RT \ln N_{A} \qquad \Delta \overline{G}_{B} = RT \ln N_{B}$$

são válidas somente para uma solução ideal, onde a fraçãe molar de um componente em solução é igual a sua atividade. Num caso mais geral, escreve-se :

$$\Delta \overline{G}_{A} = RT \ln a_{A} \qquad \Delta \overline{G}_{B} = RT \ln a_{B}$$

As equações da força exercida sobre um átomo (23) ficam :

$$F_{A} = -kT \frac{\delta \ln a_{A}}{\delta x}$$

$$F_{B} = -kT \frac{\delta \ln a_{B}}{\delta x}$$
(23)

A densidade de fluxo por unidade de volume, é portanto dada por:

$$J_{A} = n_{A} v_{A} = n_{A} M_{A} F_{A} = n_{A} M_{A} k_{T} \frac{\delta \ln a_{A}}{\delta x}$$

$$J_{B} = n_{B} v_{B} = -n_{B} M_{B} F_{B} = n_{B} M_{B} k_{T} \frac{\delta \ln a_{B}}{\delta x}$$

$$(24)$$

onde n_A, n_B =<u>número de atomos</u> A e B por unidade de volume.

Generalizando as equações de fluxo :

$$J_{i} = -\sum_{i,k} B_{ik} \frac{1}{N_{avg}} \frac{\delta \Delta \overline{G}_{k}}{\delta x}$$
 (25)

onde B_{ik} matriz de interação entre os fluxos ($B_{ik} = B_{ki}$).

Considerando um dos mais importantes mecanismos de difusão, o mecanismo dos "vazios ", pode-se chegar as relações de coeficiente de dif<u>u</u> são(por vazios) através das relações de fluxo.

Sejam J_{A} , J_{B} e $J_{V}\,$ os fluxos por unidade de volume dos átomos A , B e dos vazios :

$$J_{A} = -B_{AA} \frac{1}{2} \frac{\delta \Delta G_{A}}{\delta x} - B_{AB} \frac{1}{2} \frac{\delta \Delta G_{B}}{\delta x} - B_{AV} \frac{1}{2} \frac{\delta \Delta G_{V}}{\delta x}$$
(26 - a)
$$N_{avg} \frac{\delta x}{\delta x} - N_{avg} \frac{\delta x}{\delta x} - N_{avg} \frac{\delta x}{\delta x}$$

A partir dai, escreve-se as equações (26) da seguinte maneira :

$$J_{A} = -B_{AA} \frac{1}{N_{avg}} \frac{\delta \left(\Delta \tilde{G}_{A} - \Delta \tilde{G}_{V}\right)}{\delta x} - B_{AB} \frac{1}{N_{avg}} \delta \left(\Delta \tilde{G}_{B} - \Delta \tilde{G}_{V}\right)$$

$$J_{B} = -B_{AB} \frac{1}{N_{avg}} \frac{\delta \left(\Delta \tilde{G}_{A} - \Delta \tilde{G}_{V}\right)}{\delta x} - B_{BB} \frac{1}{N_{avg}} \frac{\delta \left(\Delta \tilde{G}_{B} - \Delta \tilde{G}_{V}\right)}{\delta x} \qquad (27)$$

 $J_v = 0$

Considerando-se uma situação de equilíbrio local, pod<u>e</u> se então escrever :

$$\Delta G_{v} = RT \ln \frac{N_{z}}{N_{z}^{o}}$$

onde N_z - número de vacâncias por cm³

 N_z^0 - número de vacâncias por cm³ na situação de equilíbrio. No equilíbrio , $N_z = N_z^0$ $\Delta G_v = 0$

Considerando-se $n_A = n_B o$ número de átomos por cm³ e <u>n</u> o número de pontos da rede por cm³, a fração molar X é dada por: $X_A = n_A / n$ e $X_B = n_B / n$. As equações (27) ficam :

$$J_{A} = B_{AA} \quad KT \quad \frac{d \ln a_{A}}{dX_{A}} \quad \frac{\delta X_{A}}{\delta x} \quad - B_{AB} \quad KT \quad \frac{d \ln a_{B}}{dX_{B}} \quad \frac{\delta X_{B}}{\delta x} \quad (28-a)$$

$$J_{B} = B_{AB} KT \frac{d \ln a}{dX_{A}} \frac{\delta X_{A}}{\delta x} - B_{BB} KT \frac{d \ln a}{dX_{B}} \frac{\delta X_{B}}{\delta x}$$
(28-b)

Usando-se considerações termodinâmicas e algebricas e, considerando-se a definição de coeficiente de difusão dada por:

$$J_{i} = -D_{i} \frac{\delta C_{i}}{\delta x}$$

da equação 28, chega-se a :

$$D_{A}^{AB} = \left[B_{AA} \quad kT / N_{A} - B_{AB} \quad kT / N_{B} \right] \frac{d \ln a}{d \ln X}$$
(29-a)
$$D_{B}^{AB} = \left[B_{BB} \quad kT / N_{B} - B_{AB} \quad kT / N_{A} \right] \frac{d \ln a}{d \ln X}$$
(29-b)

ou,

$$D_A^{AB} \stackrel{\checkmark}{=} D_A^{AB} \stackrel{AB}{=} \frac{d \ln a}{d \ln X}$$

$$D_{B}^{AB} \stackrel{\sim}{=} D_{B}^{AB} \frac{d \ln a}{d \ln X}$$

onde D_A^{AB} e D_B^{AB} são dados por :

$$D_{A}^{AB} = \begin{bmatrix} B_{AA} & kT/N_{A} & - & B_{AB} & kT/N_{B} \end{bmatrix}$$
(30-a)
$$D_{B}^{AB} = \begin{bmatrix} B_{BB} & kT/N_{B} & - & B_{AB} & kT/N_{A} \end{bmatrix}$$
(30-b)

Lembrando que a matriz B_{ik} , de interação entre os fl<u>u</u> xos, está relacionada com a mobilidade M ($B_{ik} = N_i M_i$), vê-se que as equações (29) relacionam a mobilidade M com grandezas mensuráveis, tais como : temperatura, número atômico, atividade, coeficiente de difusão, "driving force" e algumas constantes. É bom notar que somente nas reações <u>controladas por difusão</u> tem-se todas as grandezas determinadas, fato este que não ocorre em processos controlados por reação na interface, conforme ver-se-á no item 2.6.

2.5 - FORMAÇÃO DE FASES DURANTE PROCESSOS CONTROLADOS POR DIFUSÃO.

As leis de Fick para a difusão polifásica em sistemas binários fornecem as expressões abaixo para as posições da interface, em função do tempo e da temperatura(14) :

$$D = D_{0} \exp(-Q / RT)$$
 (31-a)

$$C (x,t) = C'/2 \left[1 + erf\left(\frac{x}{2\sqrt{D t'}}\right) \right]$$
 (31-b)

onde em 31-a

D - coeficiente de difusão
 D_o - fator constante independente da temperatura
 Q - energia de ativação da difusão
 R - constante
 T - temperatura

C' - concentração do soluto

- x distância entre o plano inicial do soluto e o plano em consideração
- D coeficiente de difusão
- t tempo de tratamento térmico

Kidson(15) fêz um estudo do problema do movimento das interfaces e crescimento da fatia de difusão, e provou que se pode obter expressões para estes problemas sem uma solução ex plícita para C(x,t). Aplicando a primeira lei de Fick (equação 32) diretamente a um sistema de 2,3 ou n fases, Kidson obteve uma relação entre a largura da fase e o tempo de tratamento té<u>r</u> mico aplicado ao sistema .

$$J = -D \frac{\delta C}{\delta x}$$
(32)

J - fluxo de matéria

D - coeficiente de difusão

 $\delta C / \delta x$ - gradiente de concentração

A primeira lei de Fick diz que o fluxo de matéria(J) que atravessa uma unidade de área na unidade de tempo, é pro porcional ao gradiente de concentração.

Kidson considerou inicialmente um sistema constituído por dois metais puros, os quais possuem solubilidade limit<u>a</u> da nas fases primárias e nenhuma fase intermediária(figura 10) e depois estendeu o resultado para um sistema com n fases (figura 11).

A constante de fase

Considerando constantes as concentrações nas interf<u>a</u> ces e iguais ao valor no equilíbrio, a razão do avanço da in terface até I _{αβ} é dada por :

$$J_{\alpha\beta} - J_{\beta\alpha} = (C_{\alpha\beta} - C_{\beta\alpha}) \frac{d I}{dt}_{\alpha\beta}$$
(33)

Aplicando a equação 32 à expressão 33 acima, e usan do o Teorema de Boltzman ($C(x,t) = C(\lambda)$ onde $\lambda = x / \sqrt{t}$), pos os cálculos obtem-se :

 $I_{\alpha\beta} = A_{\alpha\beta} \sqrt{t}$

(34)

30

onde ,

 $I_{\alpha\beta}$ posição da interface

A constante de fase

t tempo de tratamento térmico

Extendendo o problema para um sistema polifásico, obtem-se a expressão :

 $W_j = B_j \sqrt{t}$ (35) onde W_i é a largura da fase j, e B_j a constante de fase.

A expressão 35 exibe uma dependência parabólica do tempo, do movimento da interface, a qual é observada experimentalmente (11).

A constantante de fase B_i é expressa por :

$$B_{j} = 2\left\{ \left\{ \frac{(DK)_{j+1,j} - (DK)_{j,j+1}}{C_{j,j+1} - C_{j+1,j}} - \left[\frac{(DK)_{j,j-1} - (DK)_{j-1,j}}{C_{j-1,j} - C_{j,j-1}} \right] \right\} (36)$$

onde o coeficiente de difusão D_{i,j} e as concentrações C_{i,j} são para dados tempo e temperatura, constantes para cada interface.

A constante K_{ij} ē dada implicitamente pelos coeficiente de difusão do sistema, conforme a equação 37 :

$$K_{ij} = K_{ij}(x,t,D_1, ...,D_n) = (dC/d\lambda)_{ij} = t(\delta C / \delta x)_{ij} (37)$$

A constante B_j vai depender da razão do avanço das interfaces que limitam a fase j. O șignificado fisico de sinal da constante de fase B_j ē o crescimento ou decrescimo da largura da fase, onde B_j depen de de todos os coeficientes de difusão do sistema, através da constante K_{ij} .

Kidson, entre outros tópicos concluiu que : a) a con<u>s</u> tante de fase B_j deve ser sempre finita e positiva, ainda que pequena ; b) a largura das fases é determinada pelo balanceame<u>n</u> to das razões de fluxo e pelo"gap" de miscibilidade das duas i<u>n</u> terfaces consideradas.
INFLUÊNCIA DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO NA ESPESSURA DAS FASES.

A influência dos coeficientes de difusão na razão do crescimento das fases pode ser descrita do seguinte modo :

Se $D_{\beta} \ll \text{comparado com aqueles das fases vizinhas,}$ a razão do fluxo de material na interface ($I_{\beta\alpha}$), necessária para o avanço da fase β será muito pequeno.E por outro lado, o acúmulo de material na interface $I_{\gamma\beta}$ será rápido. Portanto, a<u>m</u> bos os efeitos tornarão a fase β muito pequena.

- se D_{β} comparado com aqueles das fases vizinhas os efeitos serão inversos e tenderão a fazer com que a fase β cresça rapidamente.

Conclui-se a partir daí que a ocorrência ou não de uma fase é governada por condições peculiares a uma temperat<u>u</u> ra particular de aquecimento e que a aplicação da 1º Lei de Fick para a difusão polifásica em sistemas binários, dá uma simples interpretação física dos vários tipos possíveis de comportamento de crescimento da fatia de difusão.

A relação 35, obtida por Kidson, que dá a dependência parabólica da largura da fase com o tempo, pode ser expl<u>i</u> cada também em têrmos de gradiente de concentração. Na figura 12, tem-se a relação entre o diagrama de equilíbrio e as curvas de concentração para um sistema trifásico, onde o processo é controlado por difusão, a temperatura T, para dois valores de tempo ($t_1 e t_2$). Observa-se uma variação no gradiente de concentração (C/S x) da curva de concentração para uma variação do tempo. Este gradiente é dado pela tangente à cur-

va, no ponto C_{ij} . A segunda lei de Fick (equação 40) relaciona o gradiente de concentração ($\delta C/\delta x$) com ($\delta C/\delta t$), e pela so lução desta lei (equação 41), vê-se que para concentrações constantes, a distância varia com a raiz quadrada do tempo.

$$\frac{d C}{d t} = \frac{\delta}{\delta x} \left(\frac{D}{\delta x} \right)$$
(40)

$$C(x,t) = C'/2 \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)\right] \quad (41)$$

O caso de formação de fases em processos controlados por difusão (sistema Fe-Ti) comprova experimentalmente a depe<u>n</u> dência parabólica do crescimento das fases com o tempo.

2.6 - FORMAÇÃO DE FASES DURANTE PROCESSOS CONTROLADOS POR REAÇÃO NA INTERFACE.

A reação controlada na interface não é até os dias de hoje, estudada em seus detalhes. Hillert (5) dã a relação entre a variação de energia livre devido a reação na in terface , ΔG_M^I e a mobilidade da interface :

$$\frac{\Delta G_{\rm M}^{\rm I}}{V_{\rm M}} = v M \qquad (42)$$

onde v- velocidade da interface M- mobilidade da interface(constante de proporcionali

V_M - volume molar

dade

A relação (42) geralmente é escrita na direção opo<u>s</u> ta :

 $\mathbf{v} = \mathbf{M} \left[\frac{\Delta \mathbf{G}_{\mathrm{M}}^{\mathrm{I}}}{\mathbf{V}_{\mathrm{M}}} \right]$ (43)

Para definir o parâmetro M, a equação 43 é escrita:

$$v = M \left[\frac{\Delta G_{M}^{I}}{V_{M}} - F \right]^{n}$$
(44)

onde F - constante de fricção

n - expoente ≠ i

Poucos trabalhos tem sido feitos para relacionar M a outras quantidades que possam ser obtidas por medidas experimentais.

A mobilidade <u>M</u> dos átomos através da interface pode ser relacionada com a difusão através da relação :

$$M = \frac{\partial D^{T} V_{M}}{b^{2} RT}$$
(45)

onde

ə largura da fase

b distância entre os átomos

D^I difusividade dos átomos

Nesta relaão 45, o valor de M está relacionado a grandezas tais como coeficientes de difusão, os quais, para a reação controlada na interface, não foram ainda medidos.

Nestes processos de reação controlada na interface, os passos da reação são governados por um mecanismo muito mais lento do que aquele que controla a difusão no volume, de modo que não se origina qualquer diferença de concentração a med<u>i</u> da que nos afastamos da interface. Na figura 5-c ve-se a variação de concentração com a distância numa amostra onde se processa uma reação controlada na interface. O gradiente de concentração (que é tangente a curva C(x)) não varia com o tempo, isto significa que a concentração varia constantemente ao longo do volume com o passar do tempo.Ocorre então um ala<u>r</u> gamento do "gap" de miscibilidade conforme pode-se observar comparando as figuras 2-c e 5-c, que fornecem as curvas de v<u>a</u> riação de concentração com a distância para os dois tipos de reação.

Com base neste princípio de que a concentração ao longo de uma amostra, onde ocorre reação controlada na interf<u>a</u> ce, varia <u>constantemente</u> com o tempo,pode-se dizer que a lei do tempo que governa o crescimento das fases é dada por :

$$W_{\alpha} = \alpha t$$
 (46)

onde W_{α} - largura da fase α - constante de fase t - tempo de tratamento térmico

A expressão acima mostra uma dependência linear do tempo, do movimento da interface, dependência esta que foi o<u>b</u> servada experimentalmente neste trabalho.

PARTE 3

3.1 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

3.1.1 - OBTENÇÃO DO PAR Fe-Ti

Ferro e Titânio puros (99,9 %)*foram cortados em pequ<u>e</u> nos blocos de dimenções 5x10x10 mm³, com faces paralelas para se obter uma boa fixação, onde as superfícies de contato dos mater<u>i</u> ais devem estar perfeitamente ajustadas uma a outra.

Cada peça de metal foi lixada a fim de serem tiradas as imperfeições da superfície, provocadas pelo processo de corte. Usou-se lixas fixas sobre discos giratórios na sequência : 400 , 600 e 800 (da mais grossa para a mais fina). As amostras eram giradas sobre a lixa em rotação, no sentido contrário ao do di<u>s</u> co, tomando-se de não tirar o paralelismo das faces(medindo-se constantemente a espessura da amostra), e examinando-as após cada lixamento em microscópio ótico.

Após o processo de lixamento, vem o processo de polimento, necessário para tirar as irregularidades da superfície, provocadas pelas lixas, onde usou-se pasta de diamante sobre p<u>a</u> no macio, fixo em disco giratório (300 a 400 rpm), com lubrificante. As rugosidades da superfície diminuiam à medida que se mudava a granulosidade da pasta de diamante. Usou-se pasta de diamante 7µm,3 µm, 1 µm e 0,25 µm, nesta sequência.

Em seguida ao polimento, a superfície das amostras f<u>o</u> ram limpas através de ultrasom, onde as amostras ficam embebidas em alcool.

Estando as superfícies planas e limpas, as amostras foram submetidas a fixação, a qual é feita prensando-se as duas peças (Fe e Ti) por meio de um parafuso (Foto 13) e submetendo

* Ver tabela de pureza (Tabela VIII).

o sistema a um tratamento térmico de 600 $^{\circ}$ C por 4 horas com a<u>t</u> mosfera inerte de A**p**, o que evita a oxidação das superfícies. O tempo e a temperatura do tratamento térmico foram escolhidos de modo a apenas fixar as duas peças fortemente(fixação por d<u>i</u> fusão) sem haver reação.

TRATAMENTO TERMICO

O tratamento térmico para as amostras de Fe-Ti foi feito de acôrdo com a tabela II, com as amostras em vácuo $(10^{-3}$ torr).encapsuladas em quartzo.

Medidas precisas de temperatura foram conseguidas c<u>o</u> locando-se o termopar(Pt-PtRh 10% ') a poucos milímetros da <u>a</u> mostra.

A seguir, as amostras foram embutidas em resina sintética, cortadas e polidas com pasta de diamante em pano macio como descrito anteriormente, após o que foram limpas por ultr<u>a</u> som e depois de fotografadas em miscroscópio ótico, analisadas qualitativa e quantitativamente na Microsonda Eletrônica e por difratometria.

3.1.2 - OBTENÇÃO DO SiO₂ - Alevaporado

As peças de quartzo natural foram cortadas nas dimen sões de 5x10x10 mm³ com superfícies paralelas. A fim de tirar algumas imperfeições deixadas pelo disco cortador, as superfí cies foram lixadas em lixa fina (nº 800). Em seguida, foram submetidas ao processo de polimento, o qual consiste em girar se manualmente a peça sobre vidro, utilizando-se pó de SiC e água destilada como lubrificante. Inicia-se o polimento com o pó de grãos maiores e termina-se com grãos menores, nesta

No final do polimento, a superfície do quartzo apr<u>e</u> senta-se lisa, sem buracos ou riscos porém, não espelhada.

As peças de quartzo foram colocadas no evaporador (Hitachi - modelo HUS- 4GB) e sobre elas foi evaporado alumínio puro (9949 % peso) sob forma de uma fina camada (0,004mm).

Foram montadas amostras do tipo sanduiche(figura 13.a)usando-se dois blocos de quartzo, tendo alumínio sobre suas superfícies de contato.

A amostra foi submetida a pressão mecânica pelo si<u>s</u> tema de parafuso(foto 13) e assim submetida a tratamento térmico feito à temperatura de 660 ^OC por 100 horas.

Para fim de análises, a amostra foi embutida em r<u>e</u> sina sintética, cortada transversalmente, polida e fotograf<u>a</u> da em microscópio ótico.

3.1.3 - OBTENÇÃO DO PAR SiO₂-Al_{Metálico}

Blocos de alumínio metálico de pureza (99,9 % peso)^{*} foram usados para reagir com quartzo natural. As dimensões dos blocos de Al foram : $5x10x10 \text{ mm}^3$, idênticas as dos blocos de quartzo. O polimento da superfície do quartzo foi semelha<u>n</u> te ao do procedimento anterior e o do alumínio foi feito com lixa nº 800, fixa em disco giratório, e em seguida com alum<u>i</u> na de 1 µm, 0,5 µm, e 0,05 µm sobre tecido macio. Após o pol<u>i</u> mento, os blocos foram superpostos de acôrdo com o esquema da figura 13.5 e fixados sob pressão mecânica foram submetidos a tratamento térmico.

O tratamento térmico , a vácuo(10^{-3} torr), das a mostras de óxido- metal está na tabela III.

Após tratamento térmico, as amostras passaram pelo mesmo processo de embutimento e polimento do sistema anterior

* O Alumínio analisado na Microssonda Eletrônica continha impurezas de Fe.

3.2 – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A preparação metalográfica das amostras, descrita em detalhes no item anterior, foi feita de maneira diversa para cada caso em especial(metal duro, metal mole,vidro).

O tratamento térmico foi feito num forno de resis tência elétrica adaptado para funcionamento com atmosfera gasosa e a vácuo.

Realizou-se três tipos de análise : ótica, qualit<u>a</u> tiva e quantitativa. As análises óticas foram feitas em mi croscópio ótico da Zeiss e as outras duas na Microsonda Eletrônica modelo XMA-5B da Hitachi - Perkin Elmer e no goniômetro horizontal -PW 138 da Philips, cujas especifica çoes principais constam das tabelas IV e V.

A microsonda eletrônica fornece informações sobre regiões muito pequenas. Seu funcionamento se baseia na detecção de raios-X característicos emitidos pela amostra, a pós ser bombardeada por um feixe de elétrons colimados. As <u>a</u> nálises quantitativas são feitas através da interpretação das intensidades relativas de raios-X isto é, da relação entre as intensidades de raios-X emitidos pela amostra padrão e pela amostra analisada.

Os dados de contagem de raios-X emitidos, foram su bmetidos ao programa Magic IV (20) para a correção final das intensidades. Parte 4

- Resultado das análises das amostras.

4 .1 - Introdução

Para o estudo comparativo de dois tipos de reação em dois sistemas distintos é necessário analisar quais são as fases formadas durante a reação e estudar a lei temporal da formação de fases.

Na análise das fases formadas , usamos a Microsonda eletrônica e o Difratômetro de raios-X. A microsonda eletrônica fornece informações sobre as concentrações nos limites das fases. Esta microanálise tem certas limitações.Uma delas é no caso de filmes finos(espessura menor que 3µm)onde se obtem informações falsas pois o diâmetro do feixe , sendo maior que a espessura da amostra, atinge regiões vizinhas a fase estudada. A outra limitação deste método de análise, é a dificuldade de se analisar elementos leves com número atômico menor que 12 (análises deste tipo dão uma grande incerteza nos resultados).

No estudo da lei temporal da formação de fases,medimos a variação das larguras das fases com o tempo de trat<u>a</u> mento térmico usando o microscópio ótico. Estas medidas só podem ser realizadas quando é provado, pela análise quantitativa das fases, que não ocorrem mudanças de concentração com o tempo, nos limites das fases.

No caso do sistema Fe-Ti, determinamos os valores de concentração em toda a extenção da zona de reação, o que nos possibilitou calcular os coeficientes de difusão deste sistema.

4.2 - ANÁLISE NO MICROSCOPIO ÓTICO

Para uma observação detalhada da superfície das amostras , estas foram fotografadas no microscópio ótico, em várias ampliações.

As fotos de 1 a 12, dão o aspécto geral da superfície das amostras. A largura das fases formadas durante tratamento térmico foram medidas sobre as fotos.

4.3 - ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

<u>A) Fe-Ti</u>

As medidas de largura das fases formadas durante trat<u>a</u> mento térmico foram feitas através das fotos da superfície das amostras(valores médios de 10 determinações).Estes valores estão na tabela IX.

Particularmente, para tempos pequenos tornou-se dif<u>í</u> cil fazer medidas independentes para cada uma das fases forma das porque a interface limite entre as duas fases não estava bem delineada. Por outro lado, o bom contraste das fases interm<u>e</u> tálicas nos lados dos metais, possibilitou-nos fazer medidas da soma das duas fases : FeTi + Fe₂Ti ,.

Os valores médios de largura das fases da tabela IX , se distribuem aproximadamente em 50 % do valor para cada fase , sendo que a fase FeTi,para tempos pequenos, mostra um valor relativamente maior que a fase Fe₂Ti.

Na fase FeTi foram encontradas precipitações de TiC* para tempos de tratamento térmico pequenos(ver figura 14).

Os valores da tabela IX foram graficados (Fig.20-a e 20-b) a fim de se analisar o comportamento da lei temporal.

Na figura 20-a tem-se os valores de x em função de t Incluindo o valor de t=0 \rightarrow x=0, ve-se que para tempos pequenos, ocorre um desvio para valores maiores, e para tempos grandes , há um desvio para valores menores.

Na figura 20-b analisamos esta mesma lei em papel loglog , e fazendo-se $x=k t^n$ encontramos n = 0,4.

 * A formação de TiC se deve provalvelmente a solução de car vão no Fe e a difusão do mesmo nas fases intermetálicas du rante o tratamento térmico. Para uma exata identificação dos compostos das novas f<u>a</u> ses formadas durante o tratamento térmico, usou-se difratometria de raios-X numa das amostras (20 h/1000 ^OC).A análise de raios-X foi feita em cinco superfícies diferentes (secção transversal) da amostra, começando-se do lado do Fe, até chegar na zona do Ti. No esquema da figura 14-a estão representados os planos de secção transversal, onde foram feitas as análises, os quais foram obtidos fazendo-se desbantes sucessivos na amostra.

A figura 14-b mostra os diagramas do difratômetro para as 5 superfícies analisadas. Nota-se na região próxima do Fe , a presença da fase Fe(Ti) e na região próxima ao Ti , a fase Ti(Fe) Nota-se também, que a intensidade da linha Fe₂Ti decresce no sent<u>i</u> do do ferreo para o titânio, equanto que a intensidade da linha FeTi cresce neste sentido. Este é um resultado esperado, que é pr<u>e</u> visto pelo diagrama de equilíbrio das fases do sistema Fe-Ti (fig<u>u</u> ra 6).

Analisando-se pontos fixos da zona da amostra na região do Fe-Ti, obteve-se os dados de concentração da tabela VII.

Fazendo-se uma varredura de raios-X ao longo da amostra obteve-se o diagrama de intensidades da figura 15(diagrama feito na Microssonda Eletrônica).

Na tabela VII tem-se os valores teóricos de concentração de Fe e Ti nas fases Fe₂Ti e FeTi. Estes valores são calculados em % peso, considerando-se os números atômicos dos elementos Fe e Ti.

Usando a equação 35 que dã o valor da constante de fase em função do tempo e da largura da fase, calculou-se os valores da constante de fase B_j para a fase (FeTi + Fe₂Ti) (tabela IX). Os v<u>a</u> lores de B_j , são finitos e nositivos (15).

Coeficiente de difusão

Feitas as análises na zona total de difusão, aplico<u>u</u> se o método de Boltzman- Matano (fig. 16 e 17) e determinou-se os coeficientes de difusão D_{Fe-Ti} que é dado por :

$$D_{\text{FeTi}}(C) = -\frac{1}{2t} \frac{\delta x}{\delta C} \int_{C_{\text{A}}}^{C_{\text{A}}} x' dC$$

Na figura 19 tem-se a variação de D_{FeTi} em $\alpha Fe(Ti)$ e β Ti(Fe).

Alguns dos valores de <u>D</u> estão na tabela X.

A curva da concentração (Fe-Ti) pela distância na amostra (10h/1000⁰C) está na figura 18.mostrando a interface original e a interface de Matano.

Para a escala de distância usada neste gráfico, é impossível mostrar a presença de fases intermetálicas (largura das fases ∿ 1 µm)

<u>B - SiO₂ - A1</u>(evaporado)

Devido a pequena espessura das novas fases formadas não foi possível fazer análise pontual na região de reação . Apenas foi possível a análise qualitativa feita segundo uma linha que atravessa a amostra (figura 21).

O diagrama de intensidades de raios-X, cujo perfil esquemático está ma figura 21, revela que a linha de Si é mais intensa na região de reação e cai de intensidade na região do alumínio. Normalmente , numa difusão de dois materiais, oco rre uma interpenetração dos átomos de um material no outro . Neste caso porém, ve-se que os átomos de Si atravessaram a c<u>a</u> mada de Al e ficaram na região de reação.

O prosseguimento de novos experimentos com este tipo de amostra, de alumínio evaporado sobre quartzo, foi interrompido pois o principal objetivo deste trabalho, que é o e<u>s</u> tudo da formação de fases, ficava prejudicado. Necessitava-se de uma área maior de A1, e por este motivo, passou-se para uma variação deste sistema SiO_2 -A1, usando-se pequenos cubos de A1 metálico.

O alumínio evaporado possui a vantagem de criar uma perfeita superfície de contato entre quartzo e o alumínio, f<u>a</u> cilitando deste modo o início da reação.

<u>C- SiO₂ - A1</u>(metálico)

As análises qualitativas indicaram a formação de várias regiões. Uma configuração geral da superfície da amostra está na figura 22. A região de reação ficou entre o Al e o SiO₂ Na extremidade da zona de reação, na direção oposta ao alumínio apareceu um filête de aspécto metálico, que revelou-se ser de Al (97 % peso). No interior da zona de reação, aparecem canais que vão do alumínio ao filete (detalhes nas fotos 7e 9).

A região de reação(Foto 8) é escura e é constituida de Al e O. Nas Extremidades do alumínio, formaram-se partículas (detalhes foto 12)[•] de aspécto metálico.

Na figura 24 tem-se o esquema de uma amostra tratada termicamente por 49 horas, à 630° C.É interessante notar que a reação que vai na direção do alumínio para o quartzo, encontro<u>u</u> se no centro do quartzo, tomando toda esta região. Nesta amos tra foi feita a análise qualitativa e quantitativa, cujos dados estão nas tabelas XII e XIII. Estas análises foram feitas nos pontos marcados nas fotos 10, 11 e 12, que dão detalhes da su perfície da amostra.

Os pontos 1,2 e 3 (foto 10) que se situam sobre o filête metálico são de alumínio. Os pontos 4 e 5 (foto 10) que pertencem a uma região semelhante a esta primeira de alumínio , possuem apena 48 % peso de alumínio. Porém esta leitura pode ser falsa pois o diâmetro do feixe pode ser pouco maior do que a largura do filête .

Os pontos 6,7 e 8 (foto 11) que pertencem a região de reação, possuem concentrações semelhantes de Al : 48,48 e 49 % peso respectivamente e concentrações de silício com pequenas variações (3, 2 e 7 % peso) em cada um dos três pontos.

ć.--

Os pontos 9,10 e 11 (foto 12) se situam sobre as partículas formadas nas extremidades do alumínio e os pontos 12 e 13 (foto 12) estão sobre o alumínio (96 % peso).

A fim de determinar os elementos presentes na regi ão de reação (Al-Si-O), fizemos um corte transversal na a mostra, na região de reação, e a submetemos a análises de raios-X(difratometria), e o resultado foi : a região de difusão é composta de Al_2O_3 (fase α) e Al.Para uma confirmação dos resultados, foi feita análise de pó, cujos resultados estão na tabela XIV.(22). Através dos dados da análise quantitativa da micro ssonda Eletrônica, foi feito um perfil esquemático das concen trações de alumínio e silício para a reação SiO₂-Al (figura 25).

As partículas (pontos 9,10 e 11, foto 12), formadas na região do Al possuem em sua constituição, além de Al e Si, Fe, Mn e Cr. Pode-se dizer que isto ocorre devido a impurezas oriundas da preparação da amostra (por exemplo, do suporte das amostras durante tratamento térmico).(Tabela XIII).

A variação da largura da fase, com o tempo de tratamento térmico pode ser observada nas fotos 3, 4, 5 e 6, que mostram a região de reação para quatro tratamentos térmicos d<u>i</u> ferentes. A largura das fases foi medida diretamente com o microscópio ótico e conferida através das fotos e estão na tabela abaixo.(tabela XI).

Os dados da tabela XI foram graficados(Figura 25) dando uma variação de x do tipo $\Delta x = k t^n$. n =1,04.

CONSIDERAÇÕES SOBRE DESVIOS

No estudo comparativo do transporte de matéria nos sólidos por reação na interface e por difusão, só existem dois valores de relevância : primeiro a possível variação de concentração nos limites das fases e segundo a determinação da lei da temperatura do crescimento das fases.

Para o primeiro caso, somente pudemos mostrar resu<u>l</u> tados qualitativos, pois para determinações exatas de concentrações nos limites de fase, se necessita de um trabalho exp<u>e</u> rimental mais acurado, conforme foi discutido por May e Casarin (22) para análises no sistema Al-Al₂Cu.

Os desvios que podem ser encontrados na determina ção da lei temporal do crescimento das fases podem ser relaci<u>o</u> nados com problemas de tratamento térmico e com as medidas de largura das fases.

Na amostra Fe-Ti , as determinações de tempo[.] foram feitas com um desvio de <mark>+</mark> 10 ⁰, sendo que os tempos de estabilisação da temperatura podem ser desprezados.

Os desvios na determinação da largura das fases FeTi e Fe₂Ti aparecem devido as dificuldades de resolução das micrografias, e de uma formação irregular das fronteiras de cre<u>s</u> cimento das fases.

Por estas indeterminações, calculamos um desvio médic de ⁺ 1 μm (25 %) para espessuras pequenas e de ⁺ 1,5μ m (15%) para espessuras maiores.

Na amostra SiO₂-Al, as determinações de temperatura não foram exatas como para o caso do Fe-Ti. Neste caso, na reg<u>i</u> ão de 630 ^OC temos uma incerteza de 720 ^O. Esta variação de temperatura, em nosso trabalho , não ocasiona mudanças notáveis nos parâmetros de reação. Isto porque normalmente, em fases líquidas, como em nosso exem plo a fase Al-Si acima do ponto eutético, a energia de ativ<u>a</u> ção é pequena, não ocasionando mudanças grandes do coeficie<u>n</u> te de difusão com a temperatura. 52

A incerteza nos valores das larguras de fase não pode ser excluída mesmo no caso do SiO₂-Al onde a largura da fase possui valores absolutos mais altos que no caso do Fe-Ti.Pode-se atribuir esta incerteza a irregularidade dos li mites das fases.

•

4.4 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

A dependência temporal do crescimento das fases é um critério importante no estudo das reações em sólidos.

Reações nos limites de fases são caracterizadas por uma lei de crescimento linear.Encontra-se frequentemente na literatura, o crescimento de fases controlado pela difusão, o qual apresenta uma proporcionalidade com \sqrt{t} . Estes dois exe<u>m</u> plos que são analisados experimentalmente neste trabalho, determinam ambas as leis de tempo.

<u>Fe-Ti</u> Para a formação das fases intermetálicas FeTi e Fe₂Ti no sistema Fe-Ti a 1000° C, foi determinada uma lei de cresci mento parabólica ($\Delta x = B t^{n}$ com n = 0,5) cujo gráfico linear incluindo o ponto t=0 está na figura 20 - a. Na figura 20 - b temos a curva logarítimica (log-log) onde n = 0,42.

O crescimento da largura das fases relativamente mais rápido para tempos pequenos, ocorre provavelmente devido a formação de TiC, o que ocasiona uma dilatação das primeiras fases enrriquecidas de Ti, onde a parte do carvão em solução difunde com uma velocidade relativamente alta ($D_C^{\rm YFe} = 4.10^{-7} {\rm cm}^2/{\rm s}$, T= 1000 $^{\rm O}$ C) (14).

As constantes de fase determinadas para FeTi e Fe₂Ti são aproximadamente iguais, então pode-se escrever :

^BFeTi = ^BFe₂Ti =
$$1/2$$
 B = 1,93 . 10⁻⁶ cm/ s²/2

onde B ē o valor medio das constantes de fase.(Tabela IX).

Os valores de coeficiente de difusão para estas a mostras, os quais foram determinados pelo método de Boltzman-Matano, estão de acordo com os valores encontrados na literat<u>u</u> ra**(**28).

Com estes valores de coeficiente de difusão, foi possível fazer uma estimação teórica das constantes de cresc<u>i</u> mento dadas anteriormente, pela equação de Kidson(equação 36) que fornece $B_{Teórico} = 1.5 \cdot 10^{-6} \text{ cm}/\sqrt{\text{s}}$.

Apesar da aproximação grosseira dos valores do gr<u>a</u> diente de concentração nos limites de fase (figura 18), e do uso dos coeficientes de difusão química e não dos coeficientes de difusão parciais no cálculo da constante de fase teórica, o valor obtido mostra um resultado relativamente satisfatório.

Si02-A1

Ao se combinar metal + óxido, deve-se necessariame<u>n</u> te encontrar mobilidades dos átomos diferentes nas duas metades da amostra. Isto está condicionado a mudança dos mecanismos de transporte ao qual está sujeita a reação (difusão por vacâncias no metal e troca de ions nos óxidos).

No caso da combinação de SiO₂ + Al , e tratamento térmico na região de 600 ^OC ,pouco abaixo da temperatura de fusão do Al, este comportamento atômico diferente dos dois l<u>a</u> dos, é reforçado por se encontrar uma fase líquida(Al-Si reação eutética) próxima do SiO₂. Esta diferença de mobilidade <u>a</u> tômica em ambos os lados da amostra SiO₂-Al, criam condições que levam a transição dos átomos da região do SiO₂ para a região do Al, controlar a velocidade da reação.

Apõs sofrer esta transição(do SiO₂ para o Al), os $\underline{\tilde{a}}$ tomos do O, devido a grande diferença de entalpia, se combinam com o Al e formam o Al₂O₃.

O Si fica em solução no resto da fase do Al e difunde-se em regiões mais afastadas da interface. O transporte do Al dentro da região de reação e o transporte do Si reduzido, é feito através de micro-canais e pela difusão na superfície.Se se exclui a possibilidade destes transportes, pode-se dizer que não hã progresso da reação, pois a mobilidade dentro do Al₂O₃ é tão pequena como no quartzo.

Determinamos uma lei linear de reação Δx_{∞} t que tem velocidade até que o quartzo seja totalmente consumido pela reação. A constante de fase é α =0.75 . 10⁻⁶ cm/ s .

Na literatura não se encontra resultados experimen tais com amostras compactas de Al.Reações com filmes finos (até 1500 A) foram feitas por Cavanagh(23) e Prabriputaloong(24).

Estes autores estudaram a reação em filmes finos de Al com SiO₂ na região sub e sobre eutética. Eles determinaram como produto de reação γAl_2O_3 (Cavanagh) e $\theta - Al_2O_3$ e $\propto Al_2O_3$ (Prabriputalong), porém em nosso trabalho , determinamos a f<u>a</u> se modificação deo Al₂O₃.

Cavanagh determinou o comportamento de reação atraves do transporte no limite de grão(energia de ativação 22 kcal/ mol) e do transporte no volume do Al no SiO₂. Como estas expe riências são feitas entre 500 e 565 ^OC (região sub-eutética) , e a espessura das amostras em geral é pequena, não se pode fazer comparações diretas com nosso trabalho.

Na tabela VI tem-se os valores dos coeficientes de difusão extrapolados para 630 $^{\circ}$ C, como também os valores de D no Al₂O₃ e SiO₂ da literatura(também extrapolados), e também o coeficiente de difusão do Si no Al líquido.

A partir da aproximação : $D = x^2 / 2t$, e usando-se os valores de largura das fases, foi possível calcular um coeficiente de difusão, o qual corresponde a velocidade de re<u>a</u> ção (tabela VI). Este valor de D, fica entre o valor para reações em filmes finos e o para difusão no líquido.

BIBLINGRAFIA

- (1) . Cullity, B.D. "Elements of X-Ray Diffraction" Addison Wesley (1959)
- (2) . R.H. Miswall Jr., J.J. Peilly, "Metal Hydrides for energy storage" - Brookhaven National Laboratory Unton, New York.
- (3) . M.A. Pick, H. Menze, Inst. Fur Fest Korperforchung KFA Julich, 517, M. Germany
- (4) . MAC Chesney, et al Bell Laboratories Murray Hill, New Jersey 07974 - USA.
- (5) . Gaskell, D. "Introduction to Metallurgical Thermodynamics"Mc Graw Hill (1973).
- (6) . Gordon, Paul Principles of phase diagrams in MaterialsScience / MacGraw Hill (1968).
- (7) . Heumann, T. Diffusions in Metallen-WestfalischeWilhelms Universitat Inst. fur Metallforshung (1970).
- (8) . M. Hillert Metall. Trans. Aime vol. 6A January (1975), p. 5.
- (9) . Kubaschewski and Evans Metallurgical Thermochemistry
 4 ed. Oxford, Pergamon , 1967
- (10) . Van Vleck, T.H. "Principio da Ciência dos Materiais" S.P. / Blucher /1970
- (11) . W. Jost "Diffusions in solids, liquids and gases", Academic Press - N.Y. (1969).
- (12) . B.H. Mahan Ouimica
- (13) . J. Burke The kinetics of Phase Transformation in Metals - Pergamon Press (1965).

- (14) . Y. Adda et J. Philibert "La Difusion dans les solids" Vol. I INSTS, Paris (1966).
- (15) . G.V. Kidson J. Nucl. Mat. 3, nº 1 (1961) 21, 29.
- (16) . K. Prabriputaloong, M.R. Piggot J. Elec. Soc., March (1974).
- (17) J.S. Best, J.O. McCaldin J. Appl. Phys. vol. 46, nº 9 (1975).
- (18) . Phase Diagrams Mat. Science and Technology vol. 61 -Edit. Allen M. Alper - New York - London (1970).
- (19) . J.W. Colby Magic IV A Computer Program for Quantitative electron Microprobe Analysis - Bell Tel. Lab. Inc.
- (20) . Darken, L.S. Trans. Metal. Soc. Aime vol. 221, 654 (1961).
- (21) . Farah, E.A. Tese de Doutoramento Instituto de Fisica UNICAMP (1978).
- (22) . May,W. ; Casarin,C. aguardando publicação no Ciência e Cultura.
- (23) . K.Prabriputaloong, Piggott,M.R. J.Elec.Soc. March 1974
 pg. 430.
- (24) . Cavanagh . , et al Japanese J. Appl. Phys. ,vol.15N.10 pp. 1877-1880
- (25) . Samsonov,G.V. The Oxide Handbook IFI/PLENUM . NYlondon - 1973 pg. 170.
- (26) . Cavanagh, E. et al -Japan. J. Appl. Phys. 15(1976) 9
- (27) Lozovskii, V.N.; Politova, N.F.; Sklyarov, Yu.I. R.J. Phys.Chem - 50(8) 1976 p 1284.
- (28) . Hirano,K, Ipposhi,Y.I. -J. Jap. Inst. Met. 1968,9,5 -815

elemento	rede	a _o (A)	c _o (A)
γFe	fep	3,639	-
αFe	bcc	2,866	_
TiFe ₂	hexagonal	4,78	7,799
TiFe	cúbica	2,976	-
βΤί	hexagonal	2,950	4,686

TABELA I

Tipos de rede Fe-Ti

nº da amostra	t(h)/1000 °C
1	5
2	20
3	40
4	80
5	160

TABELA II

Tratamento térmico do Fe-Ti(Vácuo 10⁻³ torr)

n ^e da amostra	t(h) / 6 ₃ 0 ^o C
1	16
2	36
3	49

TABELA III

Tratamento térmico Si0₂-Al_{metálico}

Tensão de operação : 5 -50 Kv <u>Sistema Eletro-Ótico</u> : 3 lentes eletromagnéticas Ótica de raios-X : 2 espectômetros c/ cristais e detetores duplos 2 detetores : xenônio selado fluxo prop. de Ar ângulo de emergência do R-X : 38 9 Ótica de Luz : Iluminação : campo claro luz polarizada luz transmitida não polarizada Magnificação : 300 X Amostra : tamanho : 1 1/4 diâmetro x 3/4 pés de espessura capacidade : 8 espécimes movimentos : X,Y,Z e rotação Feixe Eletrônico : 3 osciloscópios eletromagnéticos mag. 100 a 30.000 X Sistema de vácuo : 2 bombas mecânicas 1 bomba difusora (700 1/s)

TABELA IV

Especificações Técnicas da Microsonda Eletrônica Hitachi-Perkin-Elmer

Range de "Scanning" :
$$\theta = 360^{\circ}$$
 (-65° 2 θ 165⁶)
Leitura Acurada : p/0,01° ($\theta \in 2\theta$)
Possibilidades de "Scanning" : θ ou 2 θ + θ
Passos de "Scanning" :
1/8°, 1/4°, 1/2°, 1°, 2° (2 θ / min)

TABELA V

Especificações Técnicas do Goniômetro Horizontal PW-138 - Philips

Elemento	Sistema	D _o (cm ² /s)	Q (kcal/mo4)	D(cm ² /s)	referência
Fe ⁵⁹	A12 ⁰ 3	9,18.10 ⁻⁶	23,79	2,6.10 ⁻¹²	(25)
Ρ	si0 ₂	32 . 10 ^{-7.}	° 25,12	2,5.10 ⁻¹³	(25)
Al	si0 ₂	85	49,8	9,0.10 ⁻¹¹	(26)
Si	۸٦ _۲ نم	1,0.10 ⁻²	7,9	1,2.10 ⁻⁴	(27)
		•	· .	4,0.10 ⁻⁸	este trabalho
·	······································				

TABELA VI

.

COEFICIENTES DE DIFUSÃO CALCULADOS (630 °C)

.

	Sistemas	Tempo de tratamento (h)		Zonas	do Fe			Zonas do	Ti	
· · ·		térmico / 1000 ⁰ C	(I/ I _o) _{Ti}	(I/I ₀) _{Fe}	C _{Ti}	C _{Fe}	(I/I _o) _{Ti}	(I/I _o) _{Fe}	C _{Ti}	C _{Fe}
Análise Quantita-	Fe/Ti	20	0,297	0,699 •	0,297	0,734	0,507	0,463	0,497	Q 507
tiva.	Fe/Ţi	80	0,314	0,686	0,307	0,721	0,508	0,503	0,498	0,547
Calculados de C _{Fe} e	Fe/Ti	160	0,329	0,675	0,322	0,710	0,513	0,506	0,503	0,550
11		Fase			C _{Ti}	C _{Fe}			C _{Ti}	C _{Fe}
Valores		Fe ₂ Ti		0,	,3001	0,699				
de C _{Fe} e C _{Ti}		FeTi						0	,4617	0,5383

TABELA VII

Valores teóricos e experimentais de concentração.Sistema Fe-Ti.

•

Impurezas d	o Fe	Impurezas	do Ti
concentração	elemento	concentração	elemento
0,006	C ·	∠ 0,01	с
0,001	N	v 0,01	≪ N
< 0,001	0	N 0,02	Fe
< 0,005	Si	∿ 0,045	0
< 0,005	Al		
< 0,005	S		
< 0,005	Р		
< 0,002	Mn		

TABELA VIII

Impurezas do Fe e do Ti.

п	t(h)	x (μm)/10. m.	B _j (cm /√5)
1	5	3,40	2,50 10 ⁻⁶
2	20	5,53	2, 06 10 ⁻⁶
3	40	7,14	1,88 10 ⁻⁶
4	80	8,75	1,63 10 ⁻⁶
5	160	12,14	1,59 10 ⁻⁶

TABELA IX

Valôres da constante de fase para o Fe-Ti.

D $(cm^2/s).10^{-9}$	C(at % Ti)
1,2	1,5
1,6	2,0
2,0	2,8
2,3	3,6
2,4	4,3
2,5	5,0
2,6	5,7
2,4	80,0
3,3	81,4
4,8	83,2
7,8	85,0
8,2	87,4
10,0	89,6
13,0	92,4
13,0	95,4
	·

TABELA X

Coeficientes de Difusão Fe-Ti.

n		$\overline{\mathbf{x}}(\mathrm{mm})$ / 10	_t(h)/660 ⁰ C
1		0,38	16
2	•	1,06	36
3		1,38	49

TABELA XI

Medidas de largura de fase , em função do tempo de tratamento térmico. SiO₂-A1.

pontos	elementos (C peuo %±2)				
n	A1	0	Si	0	
1	97,18	-	1,24	-	
2	97,33	-	1,50	- 23	
3	96,69	· •	1,37	-	
4	48,79	43,32	9,15	1,04	
5	48,46	43,03	9,17	10,45	
6 •	48,63	43,18	3,46	3,94	
7	49,69	44,12	1,95	2,22	
່ 8	47,15	41,86	7,17	8,17	
9	51,84	46,03	8,36	9,53	
10	49,78	42,20	7,60	8,66	
11	49,67	44,10	7,47	8,51	
12	95,95	-	1,16	. <u>1.32</u> **	

TABELA XII

ANÁLISE QUANTITATIVA (% PESO)

AMOSTRA Si0₂-A1.

Obs. Os valores de concentração do O foram calculados por estequiometria.

		Valores obtidos		valore	s tabelados
n	Elemento	o d (A)	I _{relativa}	o d (A)	^I relativa
1	SiO ₂	4,270	10	4,260	35
2	A1203	3,481	70	3,479	75
3	SiO_2	3,350	70	3,340	100
4	A1203	2,54	90	2,550	90
5	A1203	2,370	50	2,370	40
6	A1	2,340	90	2,338	100
7	A1203	2,090	100	2,085	100
8	A1	2,040	70	2,024	47
9	SiO ₂	1,811	30	1,810	17
10	A1203	1,742	80	1,740	45
.11	A1203	1,606	90	1,600	80
. 12	A1	1,440	30	1,430	22
13	A1203	1,381	40	1,374	50
	•		<u> </u>		

TABELA XIV

ANÁLISE PELO MÉTODO DE PÓ : AMOSTRA SiO₂ - Al.

Pontos :	9	10	11
Elementos :	Fe,	Mn,	Cr

TABELA XIII

ANÁLISE QUALITATIVA. SiO₂-Al



FIGURA 1

Curva de Energia Livre em função da Composição para uma solução-Binária.


Relações de Energia e Concentração: Difusão.

.

69

a)Diagrama de Equilíbrio

das fases.

b) Diagrama de Energia Livre

c) Curva de Potencial Químico

•

d) Variação da Concentração



Reação controlada por difusão.Região de pou cas distâncias atômicas.



FIGURA 4

Reação controlada na interface.Região de pou cas distâncias atômicas.



t

FIGURA 5

Relações de Energia e Concentração:Readão Controlada na Interface.



Diagrama de equilíbrio das fases Fe/Ti .



Diagrama de equilíbrio das fases (SiO₂-A1₂O₃).



FIGURA 8

Diagrama de equilíbrio das fases (Al-Si)



Variação de energia livre de um atomo durante uma reação.



Relação entre a) curva de concentração e b) diagrama de equilíbrio de fases num sistema com solubilidade limit<u>a</u> da nas fases primárias.



Curva de concentração e diagrama de equilíbrio para um sistema polifásico.



Relação entre diagrama de equilibrio(b) e curvas de concentração a)Reação controlada por Difusãob)Reação controlada na interface.





Amostras tipo sanduiche a) SiO₂-Al_{evaporado} b) SiO₂-Al_{metálico}



Difratometria de raios-X na amostra Fe-Ti $(20h/1000^{\circ}C)$



Diagrama de intensidades na fase intermetálica. Amostra : Fe/Ti 160h / 1000⁰C .



Variação da concentração com a posição na amostra.



FIGURA 17

Relações de concentração e fluxo na amostra. Lei de Fick.





Curva de concentraçãoxdistância para Fe-Ti (10h/1000⁰C)



Curva de concentração x Coeficiente de difusão Sistema Fe/Ti (1000 ^OC).





FIGURA 20-b

Crescimento do produto de reação com o tempo. Sistema Fe-Ti.





Análise do SiO₂-Al_{evaporado}.a) Esquema da superfície da amostra b) Perfil esquemático da concentração de Si e Al na amostra.



Configuração geral da superfície do SiO₂-Al_{metálico} após tratamento térmico.





100 mm

FOTO 3

Região de reação do Al-SiO₂ Tratamento térmico : 16h/630 ^OC.



<u>FOTO 4</u> Região de reação do Al-SiO₂. Tratamento térmico 36h/630 ^OC.



FOTO 5

Região de reação do Al-SiO $_2$. Tratamento térmico. 49 h/630 °C.

<u>FOTO 7</u> 300:1



92

FOTO 8

40:1

FOTO 9

300:1

FIGURA 23

Fotos da amostra SiO₂-Al.Detalhes do esquema da Fig.22. Tratamento térmico : 100h/ 630° C.





<u>FOTO 11</u> (40 : 1)

Detalhe: canais na região de reação .



FOTO 12 (200 : 1)

Detalhe : partículas formadas nas bordas do Al.



FOTO 13

Suporte em aço inox usado para fixação de amostras.



FIGURA 25



Crescimento do produto de reação com o tempo.Sistema Sistema SiO₂-Al.